

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-205940

(43)Date of publication of application : 28.07.2000

(51)Int.Cl.

G01H 11/08

(21)Application number : 11-005695 (71)Applicant : SUMITOMO METAL IND LTD

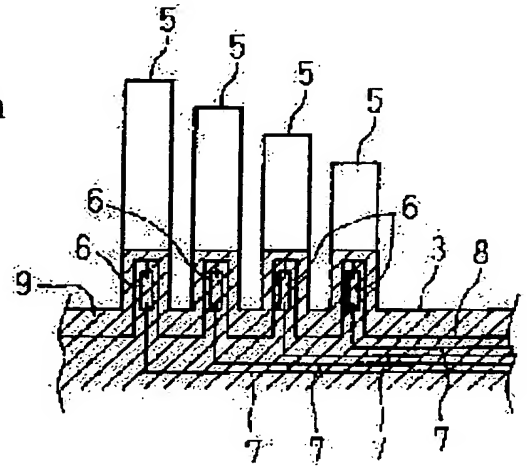
(22)Date of filing : 12.01.1999 (72)Inventor : HARADA MUNEO

(54) SENSOR ELEMENT AND OSCILLATORY WAVE SENSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sensor element such that the vibration of each plate-shaped detection element supported at one end on a support can be secured from inhibition resulting from the action of a coating formed on one side thereof and to provide an oscillatory wave sensor which is excellent in sensor characteristic and detecting accuracy by using the sensor element.

SOLUTION: An area wherein a coating 9 covering one side of a cross beam 3 serving as a support and one side of each of cantilevers 5, 5... serving as detection elements supported thereby is limited to portions where piezoelectric resistances 6, 6... provided as detecting parts near the roots of the cantilevers 5, 5... are formed and also to portions where output wires 7, 7... serving as circuit wires associated therewith and a feeder 8 are formed; areas where the coating 9 is not formed are provided at the ends of the cantilevers 5, 5... so that the vibration of each cantilever 5, 5... is secured from inhibition resulting from the action of the coating 9.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 03.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3374775

[Date of registration]

29.11.2002

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-205940

(P2000-205940A)

(43) 公開日 平成12年7月28日 (2000.7.28)

(51) Int.Cl.⁷

G 0 1 H 11/08

識別記号

FI

G 0 1 H 11/08

サーチコード (参考)

A 2 G 0 6 4

審査請求 未請求 請求項の数 9 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平11-5695

(22) 出願日

平成11年1月12日 (1999.1.12)

(71) 出願人 000002118

住友金属工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 原田 宗生

兵庫県尼崎市扶桑町1番8号 住友金属工業株式会社エレクトロニクス技術研究所

(74) 代理人 100078868

弁理士 河野 登夫

Pターム(参考) 2G064 AA11 AB01 AB02 AB14 AB16

BA02 BA05 BA08 B004 B005

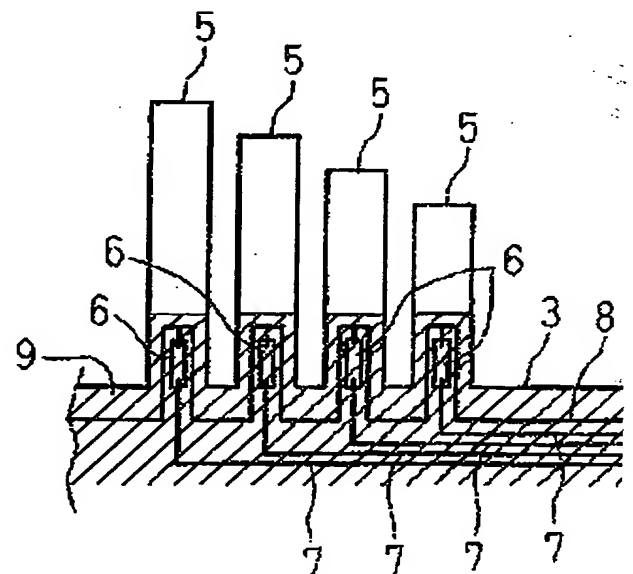
B033 B043 B032

(54) 【発明の名称】 センサ素子及び振動波センサ

(57) 【要約】

【課題】 支持体に一端を支持された板状の検出子に、これの一面に形成された被膜の作用により生じる振動阻害を抑制し得るセンサ素子を提供し、このセンサ素子を用いることにより、センサ特性及び検出精度に優れた振動波センサを提供する。

【解決手段】 支持体としての横断ビーム3、及びこれに支持された検出子としてのカンチレバー5、5…の一面を覆う被膜9の形成域を、カンチレバー5、5…の根元部近傍に検知部として設けられたビエゾ抵抗6、6…の形成部分、これに付随する回路配線としての出力線7、7…及び給電線8の形成部分に限り、カンチレバー5、5…の先端側に被膜9の非形成域を設けて、この被膜9の作用による各カンチレバー5、5…の振動阻害を抑制する。



(2)

特開2000-20594

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 板状の支持体と、該支持体に支持された板状の共振子とを備え、これらの一方の面に被膜を形成して構成されたセンサ素子において、前記一方の面の少なくとも前記共振子の一部に、前記被膜の非形成域を備えることを特徴とするセンサ素子。

【請求項2】 板状の支持体に支持された板状の共振子の一方の面に、該面を覆って形成された被膜と、前記支持体から伝播する振動波の作用による前記共振子の共振を検知する検知部とを備え、該検知部の電気的出力によって前記振動波を検出する構成とした振動波センサにおいて、前記一方の面の少なくとも前記共振子の一部に、前記被膜の非形成域を備えることを特徴とする振動波センサ。

【請求項3】 板状の支持体に支持された板状の共振子の一方の面に、該面を覆って形成された被膜と、前記支持体から伝播する振動波の作用による前記共振子の共振を検知する検知部とを備え、該検知部の電気的出力によって前記振動波を検出する構成とした振動波センサにおいて、前記被膜の形成域が、少なくとも前記検知部、及び該検知部からの回路配線の形成部分を含むことを特徴とする振動波センサ。

【請求項4】 前記検知部は、前記支持体と前記共振子との連絡部近傍に出力端を備え、該出力端は、前記支持体の一方の面に形成された出力取り出し用の回路配線に接続してある請求項2又は請求項3記載の振動波センサ。

【請求項5】 前記被膜は、電気的絶縁状態を確保するための絶縁膜である請求項2乃至請求項4のいずれかに記載の振動波センサ。

【請求項6】 共通の支持体に夫々の両面を備えて支持され、各別に異なる共振周波数を有する複数の共振子を備える請求項2乃至請求項5のいずれかに記載の振動波センサ。

【請求項7】 前記検知部は、前記共振子の振動に応じてその抵抗値を変えるピエゾ抵抗である請求項2乃至請求項6のいずれかに記載の振動波センサ。

【請求項8】 前記検知部は、前記共振子の振動に応じて変位する可動電極と、これと対向配置された固定電極とを備え、両電極間の静電容量の変化を出力として取り出す構成としてある請求項2乃至請求項6のいずれかに記載の振動波センサ。

【請求項9】 前記被膜の形成域は、前記可動電極の形成部分を含む請求項8記載の振動波センサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は、板状の支持体に支持された板状の共振子とを備え、これらの一方の面に被膜を形成して構成されたセンサ素子において、前記一方の面の少なくとも前記共振子の一部に、前記被膜の非形成域を備えることを特徴とするセンサ素子に関する。

2

ることにより、コンパクトな構成でありながら周波数解析機能を持たせることができ、音声認識、音響計測、動計測等の技術分野において好便に用い得る振動波センサ、及びこの振動波センサに用いられるセンサ素子とする。

【0002】

【従来の技術】 各種の音声をコンピュータに認識するための音声認識システム等の技術分野においては、その周波数成分を有する振動波として与えられる振動波（音）を周波数分解して検出する機能を有するコンパクトな構成の振動波センサの開発が重要な課題となっており、この課題に応え得る振動波センサの一つとして、例えば、W.Benecke et al., "A Frequency-Selective ezoresistive Silicon Vibration Sensor," Digest Technical Papers of TRANSDUCERS '85, pp.105-108 (1985). 又はE.Peeters et al., "Vibration Signature Analysis Sensors for Predictive Diagnostics," Proceedings of SPIE '97, vol.3224, pp.220-230 (1997) 等記載された共振子アレイ形の振動波センサが知られている。

【0003】 この振動波センサは、夫々異なる周波数の振動波に対して共振するように寸法設定された複数のカンチレバー（共振子）を、夫々の端部を共通の支持体支持させてアレイ状に並設してなるセンサ素子を用い前記カンチレバーの一面に、夫々の振動に応じた電圧出力を発生する検知部を各別に形成して、前記支持体を通じて伝播する振動波により前記カンチレバーのいずれかが共振したとき、対応する検知部の出力により、毎振動レベルが得られるように構成したものである。

【0004】 前記検知部は、例えば、各カンチレバーの一面に形成したピエゾ抵抗とし、夫々に対応するカンチレバーの共振によって生じる抵抗値の変化を、各ピエゾ抵抗を含めて構成された各別のホイートストンブリッジの出力として取り出す構成とすることができる。また、カンチレバーは、これらの基部を支持する支持体等に、マイクロマシン加工技術を用いて半導体シリコン板上に一体形成されている。

【0005】 前記ピエゾ抵抗は、各カンチレバーの近傍の一面にポリシリコンを積層して形成され、この支持体の表面に導電性金属によりパターン形成された出力取り出し用の回路パターンに接続されており、その文獻（Vibration Signature Analysis Sensors for Predictive Diagnostics,）に記載されているように、ピエゾ抵抗を含むホイートストンブリッジを構成し、ホイートストンブリッジの出力をマルチプレクサにスイッチングして逐次読み出し、周波数毎の振動レベルを出力する。

おけるピエゾ抵抗の形成部分、及び前記回路パターン
の形成部分は、その絶縁を確保することから、
複数のカンチレバー及びこれらの支持体における前記ピ
エゾ抵抗及び回路パターンの形成面の全面に、 SiO_2
等の絶縁材料製の被膜を成膜してピエゾ抵抗及び回路パ
ターンの形成部分を覆い、前記絶縁を確保する構成とす
る必要がある。

【0007】ところが、前記カンチレバーの夫々は、数
 μm ～数十 μm 程度の厚みと、数十 μm 程度の幅とを有
する薄肉細幅のビームとして構成されており、これらの
一面に前記被膜を形成した場合、該被膜の内部応力の作
用により各カンチレバーに反りが発生すると共に、これ
らの振動が阻害されて各別に設定された共振周波数に狂
いが生じ、センサ特性及び検出精度の低下を招くという
問題があることが新たに判明した。

【0008】また、前述したセンサ素子を用いた振動波
センサとして、カンチレバーの先端近傍に形成された可
動電極と、これに対向配置された固定電極とによりコン
デンサを構成とし、カンチレバーの振動に伴う可動電極
の変位による前記コンデンサの静電容量の変化を出力と
して取り出す構成とした場合、前記可動電極の絶縁確保
のために、該可動電極の形成面の全面を、カンチレバー
及びこれの支持体を含めて絶縁性の被膜により覆う必要
があるが、この被膜によりカンチレバーの振動が阻害さ
れ、センサ特性及び検出精度の低下を招くという問題が
同様に発生することが新たに判明した。

【0009】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたもの
であり、板状の支持体と、該支持体に支持された板状の
共振子（カンチレバー）とを備えるセンサ素子における
被膜の形成範囲を限定し、この被膜形成による共振子の
振動阻害を可及的に低減して、このセンサ素子を用いる
ことにより、センサ特性及び検出精度に優れた振動波セ
ンサを提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明の第1発明に係る
センサ素子は、板状の支持体と、該支持体に支持された
板状の共振子とを備え、これらの一方の面に被膜を形成
して構成されたセンサ素子において、前記一方の面の少
なくとも前記共振子の一部に、前記被膜の非形成域を備
えることを特徴とする。

【0011】この発明においては、支持体に支持された
共振子の一部に被膜の非形成域が設けてあり、支持体を
介して伝播する振動波に共振して生じる共振子の振動が
前記被膜の存在により阻害される程度を軽減する。前記
共振子は、好適にはカンチレバーとして構成される。

【0012】本発明の第2発明に係る振動波センサは、

を検出する構成とした振動波センサにおいて、前記
の面の少なくとも前記共振子の一部に、前記被膜の
形成域を備えることを特徴とする。

【0013】この発明においては、支持体に支持さ
れた共振子の一部に被膜の非形成域が設けてあり、支持
介して伝播する振動波に共振して生じる共振子の振動が
前記被膜の存在により阻害される程度が軽減され、
により共振子の一部に設けた検知部の電気的出力に、
前記振動を高精度に検出することを可能とする。

【0014】本発明の第3発明に係る振動波センサ
は、板状の支持体に支持された板状の共振子の一方の面
に該面を覆って形成された被膜と、前記支持体から伝
播する振動波の作用による前記共振子の共振を検知する
部とを備え、該検知部の電気的出力によって前記振動
を検出する構成とした振動波センサにおいて、前記
の形成域が、少なくとも前記検知部、及び該検知部
の回路配線の形成部分を含むことを特徴とする。

【0015】この発明においては、共振子における
の形成域を、絶縁が必要な検知部、及びこの検知部
の回路配線の形成部分の近傍に限り、共振子の大部
分を被膜の非形成域とし、該被膜による共振子の振動阻
害を可及的に軽減して高精度での振動波の検出を可能と
する。

【0016】本発明の第4発明に係る振動波センサ
は、第2又は第3発明の振動波センサにおける検知部が、
前記支持体と前記共振子との追接触近傍に出力端を備
え、該出力端は、前記支持体の一方の面に形成された出
力出し用の回路配線に接続してあることを特徴とする。

【0017】この発明においては、共振子の一方の
面における検知部の形成態様を工夫し、この検知部から
伝播する回路配線の形成部分を支持体の一面に限定して、共
振における被膜の形成域を前記検知部の形成部分のみと
し、該被膜による共振子の振動阻害を可及的に軽減して
高精度での振動波の検出を可能とする。

【0018】本発明の第5発明に係る振動波センサ
は、第2乃至第4発明のいずれかの振動波センサにおい
て、前記被膜が、電気的絶縁状態を確保するための絶縁
膜であることを特徴とする。

【0019】この発明においては、共振子の一方の
面を被膜を、電気的絶縁状態の確保のために不可欠
な被膜に限り、この被膜による共振子の振動阻害を可
及的に軽減して高精度での振動波の検出を可能とする。

【0020】本発明の第6発明に係る振動波センサ
は、第2乃至第5発明のいずれかの振動波センサにおい
て、共通の支持体に夫々の両面を備えて支持され、各別
なる共振周波数を有する複数の共振子を備えること

し、種々の周波数成分を含む振動波を、周波数毎の振動レベルを含めて精度良く検出する。

【0022】本発明の第7発明に係る振動波センサは、第2乃至第5発明のいずれかの振動波センサの検知部が、前記共振子の振動に応じてその抵抗値を変えるピエゾ抵抗であることを特徴とする。

【0023】この発明においては、被膜の影響を軽減されて生じる共振子の振動を、これの一部に形成したピエゾ抵抗の抵抗値の変化として精度良く検出する。

【0024】本発明の第8発明に係る振動波センサは、第2乃至第5発明のいずれかの振動波センサの検知部が、前記共振子の振動に応じて変位する可動電極と、これと対向配置された固定電極とを備え、両電極間の静電容量の変化を出力として取り出す構成としてあることを特徴とする。

【0025】この発明においては、被膜の影響を軽減されて生じる共振子の振動を、該共振子の一部に形成された可動電極と、これと対向配置された固定電極との間の静電容量の変化として精度良く検出する。

【0026】本発明の第9発明に係る振動波センサは、第8発明の振動波センサにおける被膜の形成域が、前記可動電極の形成部分を含むことを特徴とする。

【0027】この発明においては、共振子における被膜の形成域を、絶縁が必要な可動電極の近傍に限り、共振子の大部分を被膜の非形成域とし、該被膜による振動阻害を可及的に軽減して高精度での振動波の検出を可能とする。

*【0028】

【発明の実施の形態】以下本発明をその実施の形態す図面に基つて詳述する。図1は、本発明の振動センサの第1の実施の形態を示す平面図である。図示く振動波センサは、振動波を受ける板状のダイヤフラム2と、該ダイヤフラム2にその一端を連設された横断梁3と、該横断梁3の他端に連設された終止板4とを備え、該終止板4と前記ダイヤフラム2との間、前記横断梁3の一方の側に、これの長手方向に、本のカンチレバー（共振子）5、5…を並設して構成されたセンサ素子1を備えている。このようなセンサ1は、マイクロマシン加工技術により、図示の如く、体シリコン基板20の一部に一体形成することができ、

【0029】カンチレバー5、5…の支持体としての横断梁3は、ダイヤフラム2の側が広幅であり、終止板4の側が狭幅であって、これらの間にて連続的に変化する幅を有して形成されている。このような横断梁3の一方側に並設された複数本のカンチレバー5、5…は、夫々が異なる周波数の振動に共振するように、すなわち、夫々が異なる共振周波数を有するように寸法設定された薄肉細幅のビームであり、夫々の長手方向の一端は横断梁3に片持ち支持させ、これと略直交する一端に突設されている。

【0030】以上の如きカンチレバー5、5…の寸法は、夫々を共振させるべき共振周波数 f を与えたと下記(1)式に従って設定することができる。

$$f = (CaY^{3/4}) / (X^3 s^{1/4}) \quad \dots (1)$$

但し、C：実験的に決定される定数

a：各カンチレバー5の厚さ

X：各カンチレバー5の長さ

Y：材料物質（半導体シリコン）のヤング率

s：材料物質（半導体シリコン）の密度

【0031】なお実際には、夫々のカンチレバー5、5…の厚さaは、ダイヤフラム2、横断梁3及び終止板4を含めて一定とし、夫々の長さXを変えることにより各別の共振周波数 f を得るようにしている。このようにして定められた夫々の長さXを有するカンチレバー5、5…は、支持体としての横断梁3に、図における右側（ダイヤフラム2側）から左側（終止板4側）に向かうにつれて順次長くなるように並設され、各カンチレバー5、5…の共振周波数が、ダイヤフラム2の側から終止板4の側に向かうに従って高周波数から低周波数に移行するように配置されている。

【0032】以上の如く構成されたセンサ素子1において、音声、音響等、種々の周波数の振動を含む振動波が

る夫々の共振周波数の振動成分にตอบสนองして共振する。

【0033】各カンチレバー5、5…は、夫々の振動（横断梁3との連設部）近傍の一面に、検知部としてのピエゾ抵抗6、6…を備えている。これらのピエゾ抵抗6、6…は、前述した振動の伝播により該当するカンチレバー5、5…が共振したとき、これにより生じる歪みに応じてその抵抗値を変える公知の素子である。

【0034】図2は、カンチレバー5、5…の振動部におけるピエゾ抵抗6、6…の形成態様の説明図である。図示の如くピエゾ抵抗6、6…は、夫々のカンチレバー5、5…の一面に、これらに長手方向に沿わせ、矩形の平面形状を有するシリコン基板の表面に、拡散として形成されている。これらのピエゾ抵抗6、6…のカンチレバー5、5…の先端側の端部は、共通の給電線8により図示しない直流電源に接続されており、また、ピエゾ抵抗6、6…のカンチレバー5、5…の振動部端部は、各別の出力線7、7…により図示しない出力

振動波によりカンチレバー5、5…が共振したとき、これに応じた各別のピエゾ抵抗6、6…の抵抗値の変化が、前記出力線7、7…を介して接続された出力回路の出力として各別に検出され、前記振動波に含まれる周波数毎の振動レベルが得られるようになっている。

【0036】検知部としてのピエゾ抵抗6、6…に連なる回路配線としての前記給電線8及び出力線7、7…は、前記カンチレバー5、5…の支持体としての横断ビーム3の一方の面(ピエゾ抵抗6の形成面と同側の面)に、導電性金属による回路パターンとして形成されており、前記給電線8は、各カンチレバー5、5…と横断ビーム3との連結部において、夫々のピエゾ抵抗6、6…の形成部分を囲うように先端側に延長され、この延長部の中途にて各ピエゾ抵抗6、6…の他端に接続されている。

【0037】以上の如くピエゾ抵抗6、6…、出力線7、7…及び給電線8及び形成されたカンチレバー5、5…並びに横断ビーム3の一方の面は、検知部としてのピエゾ抵抗6、6…並びに回路配線としての出力線7、7…及び給電線8の形成部分における絶縁確保のために、シリコンの熱酸化により得られるSiO₂膜等の絶縁材料製の被膜9により覆われているが、本発明に係る振動波センサにおいては、以上の如き被膜9が、図2中にハッチングを施して示す如く、絶縁が不可欠な前記ピエゾ抵抗6、6…、出力線7、7…及び給電線8の形成域を少なくとも覆うように形成されている。

【0038】これによりカンチレバー5、5…の一面は、ピエゾ抵抗6、6…及びこれらを囲う給電線8が形成された夫々の根元部近傍のみが前記被膜9により覆われ、先端側の大部分が被膜9の非形成域として残された状態となる。従って、前記被膜9の内部応力の作用による各カンチレバー5、5…の反りの発生を抑えることができ、これに起因するカンチレバー5、5…の振動阻害が抑制されて、前述の如き振動波の伝播に伴う各カンチレバー5、5…の共振が、前述した寸法設定により決定された夫々の周波数の振動に対して正確に生じるようになり、検知部としてのピエゾ抵抗6、6…の出力により正確な振動波の検出が可能となる。

【0039】なお、以上の如き被膜9の非形成域は、前記SiO₂膜の場合、例えば、カンチレバー5、5…及び横断ビーム3を含めたセンサ素子1の一面の全体の熱酸化により、全面を覆うSiO₂膜を形成しておき、その後のエッチングにより、各カンチレバー5、5…の先端側のSiO₂膜を除去する手順により実現することができる。

【0040】図3は、本発明に係る振動波センサのカン

ての横断ビーム3との連結側にその開口側の端部をせたコの字形の平面形状を有して形成され、前記端部を、横断ビーム3の一面(ピエゾ抵抗6の形成面と同側の面)に回路パターンとして形成された各別の線7、7…、及び共通の給電線8に接続して振動波センサが構成されている。

【0041】以上の如く構成された振動波センサにても、カンチレバー5、5…及び横断ビーム3の一面は、図3中にハッチングを施して示す如く、絶縁が欠なピエゾ抵抗6、6…、出力線7、7…及び給電線の形成部分を絶縁材料製の被膜9により覆っており、カンチレバー5、5…の一面は、その先端側の大部分が被膜9により覆われていない非形成域として残されている。

【0042】ここで、図3に示す実施の形態においては、カンチレバー5、5…の一面におけるピエゾ抵抗6、6…が、前述したコの字形の平面形状を有してされ、出力線7、7…及び給電線8との接続が、横断ビーム3との連結側に向けた端部においてなされる構成であり、カンチレバー5、5…の一面に出力線7、7…及び給電線8が形成されていないことから、カンチレバー5、5…における前記被膜9の形成域が、ピエゾ抵抗6、6…の形成部分にのみ限られ、該被膜9の非形成域をより大きくすることができる。これにより各カンチレバー5、5…の反りの発生、及び振動阻害が一層に抑制され、これらのカンチレバー5、5…の共振め設定された共振周波数においてより正確に生ぜしことができ、検知部としてのピエゾ抵抗6、6…のにより正確な振動検出が可能となる。

【0043】図4は、図2及び図3に示す本発明に係る振動波センサの出力特性を、カンチレバー5、5…一面が被膜9(厚さ5000ÅのSiO₂膜)により覆われた従来の振動波センサと比較した結果を示すグラフである。図の横軸は、ダイヤフラム2に入力される振動としての音波の音圧レベル、同じく縦軸は、ピエゾ抵抗6、6…の出力側に得られる出力電圧のレベルである。図中の一点鎖線は、従来の振動波センサの出力特性、同じく実線は、図2に示す振動波センサの出力特性、同じく破線は、図3に示す振動波センサの出力特性を示している。

【0044】本図に示す如く、本発明に係る振動波センサにより得られる出力電圧のレベルは、従来の振動波センサのそれよりも極めて高く、同一の音圧レベルのを与えた場合の出力電圧を比較した場合、図2に示す振動波センサの出力電圧V₁は、従来の振動波センサの出力電圧V₂の略2、3倍、図3に示す振動波センサの出力電圧V₃は、従来の振動波センサの出力電圧V₂の略4、5倍である。

【0045】なお以上の実施の形態においては、カンチレバー5の振動を検知する検知部として、これの根元部に構成されたピエゾ抵抗6を用いた振動波センサについて述べたが、前記検知部の構成は、ピエゾ抵抗6に限らず、他の構成とすることも可能である。

【0046】図5は、カンチレバーの振動を静電容量の変化を利用して検知する構成とした静電容量形の検知部を備える本発明に係る振動波センサの側面図である。図示の振動波センサは、ガラス基板10の一部に積層された絶縁体製の基層11を介して支持されたシリコン製の支持

基板12の一侧に、これに片持ち支持されたカンチレバー13を備えている。
【0047】カンチレバー13の先端のガラス基板10との対向面には可動電極14が形成されており、ガラス基板10表面の該当位置に形成された固定電極17に対向させてある。またガラス基板10の他部には、その一侧を絶縁体製の基層15により支持してシリコン製の回路基板16が備えられ、この回路基板16は、パンプ18を介して前記固定電極17に接続されている。そして、前記カンチレバー13の先端側の前記固定電極17との対向面は、少なくとも前記可動電極14の形成部分を含めて絶縁性を有する被膜により覆ってある。

【0048】以上の如く構成された振動波センサにおいて、振動波の伝播によりカンチレバー13が共振すると、この振動に応じてカンチレバー13先端の可動電極14が、ガラス基板10表面の固定電極17に接触するように変位し、これらの電極14、17により構成されたコンデンサの静電容量が変化することから、この静電容量の変化を出力として取り出すことにより振動波の検出が行われる。

【0049】このような静電容量形の振動波センサにおいては、カンチレバー13の変位に伴って可動電極14と固定電極17とが接触し、両者間に短絡が発生する虞れがあったが、前述の如く、カンチレバー13の可動電極14の形成面が絶縁性を有する被膜により覆ってあるから、前記短絡の発生を回避でき、また前記被膜の形成域が、前述の如く、絶縁が不可欠な可動電極14の形成部分とされ、カンチレバー13の根元側の大部分が被膜の非形成域とし*

＊であることにより、該カンチレバー13の振動阻害がされ、センサ特性及び検出精度の向上を図ることができる。

【0050】

【発明の効果】以上のように本発明に係るセンサ素及びこれを用いて構成された振動波センサにおいて、板状の支持体に支持された板状の検出子の一部に被膜の非形成域を設けたから、前記被膜の内部応力による検出子の反り、及び振動阻害の発生を抑制でき、良好な状態で正確な振動波の検出が可能となる等、本発明の効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る振動波センサの第1の実施の形態を示す平面図である。

【図2】図1に示す振動波センサのカンチレバーの部近傍におけるピエゾ抵抗の形成態様の説明図である。

【図3】本発明に係る振動波センサのカンチレバーの部近傍におけるピエゾ抵抗の形成態様の他の実施態様を示す説明図である。

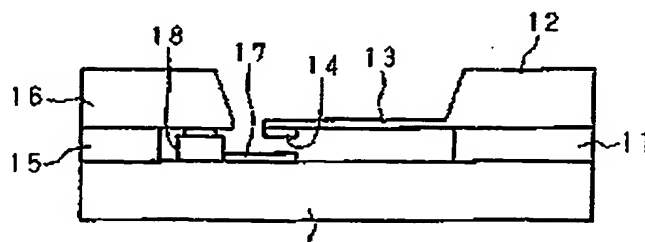
【図4】本発明の振動波センサによる出力特性の向きの説明図である。

【図5】静電容量形の検知部を備える本発明に係る振動波センサの側面図である。

【符号の説明】

- 1 センサ素子
- 2 ダイアフラム
- 3 横断ビーム
- 4 終止板
- 5 カンチレバー
- 6 ピエゾ抵抗
- 7 出力線
- 8 給電線
- 9 被膜
- 13 カンチレバー
- 14 可動電極
- 17 固定電極

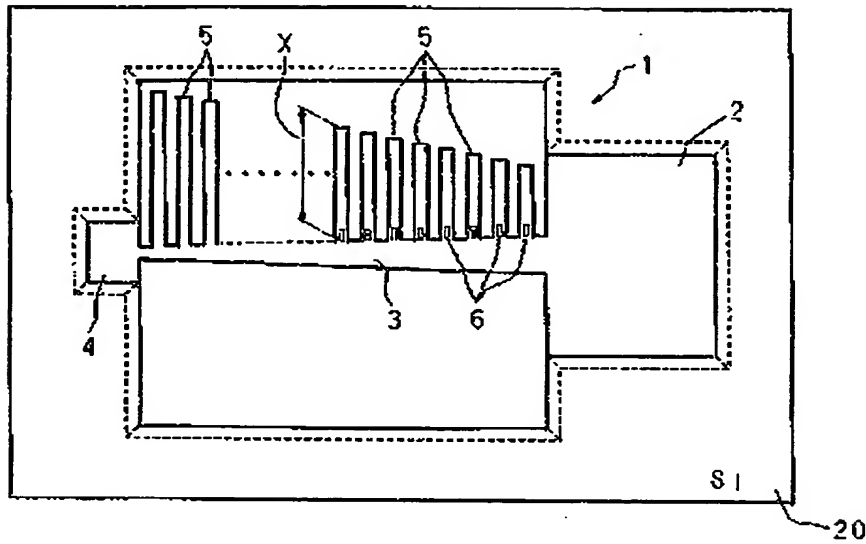
【図5】



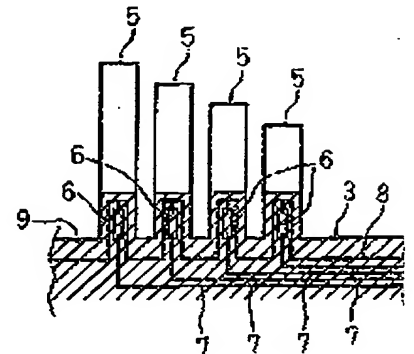
(7)

特開2000-20594

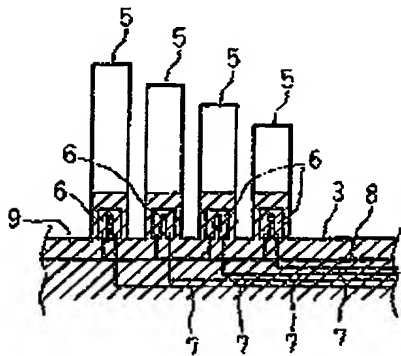
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

